

演題：**高性能・高信頼性 ULSI 多層配線形成用
原子層プロセスの開発**

講師：**霜垣 幸浩 教授**
東京大学大学院工学系研究科
マテリアル工学専攻



日時：2025 年 8 月 18 日（月）15:00~16:00

場所：工学部アカデミックラウンジ 3

主催：北海道大学工学研究院フロンティア化学教育研究センター

共催：北海道大学半導体フロンティア教育研究機構

要旨：

半導体デバイス微細化に伴い、ULSI 多層配線では、エレクトロマイグレーションによる信頼性劣化や、Cu よりも実効抵抗率の低い新材料の導入が課題となっている。本講演では原子層堆積・エッチング（ALD・ALE）を駆使した原子層プロセスによるアプローチを中心に、2nm 世代以降を見据えた今後の展望について述べる。

連絡先：工学研究院応用化学部門 幅崎 浩樹（内線：6575）